Requested Patent:

JP56142629A

Title:

VACUUM DEVICE;

**Abstracted Patent** 

JP56142629;

**Publication Date:** 

1981-11-07;

Inventor(s):

TSUMURA SUEO;

Applicant(s):

**NEC CORP:** 

Application Number:

JP19800046690 19800409 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/205; H01L21/265; H01L21/285; H01L21/302; H01L21/31;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To enable continuous treatment in high vacuum by forming a slit, through which semiconductor wafers can pass, to a block connecting several vacuum chambers, the degree of vacuum thereof is increased by stages.

CONSTITUTION:A slit 3A in an extent that semiconductor wafers 1 can pass is made up to a block 3 conneting several vacuum chambers, which have exhaust pipes and the degree of vacuum thereof is increased by stages, and the semiconductor wafers 1 are successively transported to the next vacuum chambers by means of 0 ring belts 2 (4 are 0 ring belt holes). Thus, the wafers 1 can continuously be sent into high vacuum chambers from atmospheric pressure without using vacuum valves.

# (9) 日本国特許庁 (JP)

# 10特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭56—142629

①Int. Cl. <sup>3</sup> H 01 L 21/205 21/265 21/285 21/302 21/31	<b>識別記号</b>	庁内整理番号 7739—5F 6851—5F 7638—5F 6741—5F 7739—5F	<ul><li>②公開 昭和56年(1981)11月7日</li><li>発明の数 1</li><li>審査請求 未請求</li><li>(全 3 頁)</li></ul>
. 21/31		1103-01	(± 3 A)

## 60真空装置

创特

顧 昭55-46690

②出 顧.昭55(1980)4月9日

**0**発 明 者 津村末朗

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

创出 顧 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

の代 理 人 弁理士 菅野中

明 編 有

1.発明の名称

真空装置

### 2.条許請求の範囲

(1) 段階的に実空度を高めた幾つかの実空室と、その各実空室を脱気する排気管と、各実空室を送続するプロックとからなり、プロックに 半渉体ウェハースが通過出来る程度のスリットを設け、半導体ウェハースを通出来る程度のスリットを設け、半導体ウェハースをスリットを通して一の実空室から他の実空室へ移送するのリングペルトをプロックと実空室とに表つて配数してなる実空装置。

#### 3.発明の詳細な説明

半導体ウェハースの生産プロセスにおいて、 近年、真空中で処理を行う工程が多くなつている。たとえば、蒸着、スペッタリング、プラズマロVDイオン住入等である。 ところが、大気中のウェハースを処理室である。 る真空室内に入れるに当つて、ほとんどのもの はパッチ処理によつて行をわれ、又、キャリアックャャリアでないためにクエハースハンドリングが非常に頻振であつた。

本発明は、複雑な機構を用いずにキャリアか ちゥエハースを一枚ずつ高真空室に送り込み再 び大気中のキャリアに連続的に戻すことの出来 る真空装置を提供するものである。

以下本発明の実施例を図によつて説明する。 第1図において、1はウェハース、2はウェハースを乗せて搬送するための0リングベルトで ある。該ベルト2は、直方体プロック3にあけ られた孔4を通してはプロック3及び真空室7 にまたがつて配設され、プロック3にはウェハース1が迫ることができる程度の大きさのスリット3Aが過口されている。

第2回はローダ偶又はアンローダ側のキャリア 6 からウェハーが出て行き又逆にキャリア 6 に入つてくる部分を示す。凶中7 は真空室の一つを示し、8 はその排気者である。 5 はキャリアに 1 ピッチザつ上下送りを与えるエレベータ

である。

第3 図は本発明の金体のシステムの一実施例を示すものである。キャリア 6 から出たウェハースは 71 ~ 74 ~ 71 までの各実空窟を通りキャリア 6 に入る。

各真空窟はそれぞれ排気管 8 に設けたパルプ 9 を介して下記の真空変に排気されている。

**室 71 は 10 Torr** 

**室 72 は 10-1Torr** 

**室 7: は 10 - \*Torr** 

室 74 は 10 − 5Torr. (ウェヘー処理室) 各室はそれぞれの真空度に応じた種類のポン

各盆はぜれぞれの其空度化応じた種類のポンプで脱気されている。

本発明化おいて、各実空宝の間にはいつさい パルプがなく其空宝の両畑には、第1回に示す スリットを持つたブロック3で連結されている。

したがつて、各宝の真空度は所要の値に保持 されているかどうかが問題となる。

プロック3のコンダクタンスCを計算すると 次のとかりである。

ととで、相撲する真空宝の真空度を Pn「Torr」 Pn+1「Torr」とするとn 番目の室からn+1番目 の室に使入する(今 Pn>Pn+1 とする) ガス量は

Qin = Pn·C である。

P=+1 室に付いているポンプの実効排気スピードを =+18eとナれば

n+1<sup>8</sup>e · Pn+1 = Qin = Pn · Cでメランスする。

Pn+1 × 100 = Pn とすれば

$$nH^{8}e^{}=\frac{P_{n}}{P_{n+1}}\cdot C=100\cdot C$$
 (4)  
(1)、(2)、(3) 式の結果からのは最大でも 0.6  
「4/8」であるから

p+1<sup>8</sup>6 = 100 × 0.-6 = 60「L/B」 となり、各室には 60「L/B」以上の排気スピー ドのポンプをつないでかけば、第3図のシステムにより充分に各室の真空変が保たれることが 刊る。

すなわち、本発明の実施例では第1図に示す ブロック3のスリットの高さ。= 1 「 mm 」 スリットの巾 b = 100 「 mm 」 ブロックの長さ 短形質のコンダクタンス C「L/8」は 粘性液(760Torr ~ 10<sup>-2</sup>Torr)に対して VA RISCAIR 0.26 L a<sup>2</sup> b<sup>2</sup> PM + PA2 分子液(10<sup>-4</sup> ~ 10<sup>-6</sup>Torr) に対して C = 30.9 KR a<sup>2</sup> b<sup>2</sup> (a+b) L である。 いま、a = 0.1 [ cm ] b=10 [ cm ] L=10 [ cm ] PA1 = 760 [ Torr ] ※ 1000 [ Torr ] PA2 = 10 [ Torr ] とすると a / b=(.1/0.01 の時 粘性液で KR = 0.02 分子液で KR = 2

分子流で KB = 2 であるから  $V_B = 0.26 \cdot 0.02 \cdot \frac{0.1^2 \times 10^2}{10} \cdot \frac{1000 + 10}{2}$   $= 0.26 \cdot 0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.00 \cdot$ 

と= 100 「mm」とし、各真空室にはそれぞれの真空度に応じた種類の実効排気スピード 60 「2/8」以上の排気系及びポンプを散ける事により図3 に示す様なシステムで両端開放でウェヘースを大気圧から 10<sup>-5</sup> 「Torr」に被圧し、又逆に大気圧まで連続的に通過させることが可能となつた。

以上のよりに本発明によれば、何ら真空パルプを用いる事なくウエハースを大気圧から高真空室内に連続的に送り込み、又逆に高真空室内より連続的に大気中にウエハースを取出す事ができ、全行程を0リングペルトに乗せてキャリアフウキャリアで処理を行なりことができる。

なか、第3因のシステムは一実施例であり、 $P_{D+1}=10^{-2}$  ·  $P_{D}$  とすれば、

処理室の真空度 10<sup>-5</sup>「Torr」にとどまらず、 さらに、高真空(実際はポンプその他の関係で 10<sup>-7</sup>「Torr」程度)に上げることも可能である。 4.図面の簡単な説明

第1 図は各真空窟連結プロックの斜視図、第 2 図はロード、アンロード雑都を示す側面図、

#### 館 3 図は全システム系統図である。

- 1 …ウエハース
- 2 … 0 リングペルト
- 3 …プロック
- 34 … スリツト
  - 4 …0リングペルト穴
  - 5 …キャリアエレペータ
  - 6 …キャリア
  - 7 … 71 ~ 74 真空室
- 8 … 拼気管
- 9 … パルブ

#### 袋幹出顧人 日本管包株式会社

#### 代理人 弁理士 菅 野 中

